

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2025-041

南京国博电子股份有限公司

关于自愿披露公司发布新产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）与国内头部终端厂商共同研发的硅基氮化镓功率放大器芯片（以下简称“功放芯片”），在手机等终端中成功量产应用，累计交付数量超100万只。
- 风险提示：公司新产品导入周期较长，新技术的持续迭代需要研发周期，大批量销售尚需一定的周期和前期技术服务投入，存在不确定性，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况，现将新产品进展情况披露如下：

一、新产品基本情况

公司与国内头部终端厂商共同研发的硅基氮化镓功放芯片，针对手机等终端应用进行设计优化，填补了业内硅基氮化镓功放终端射频应用的空白。新产品攻克了硅基氮化镓外延的晶格缺陷比例高的材料难题，充分发挥了新型三代半导体材料的技术优势，在兼顾功率、效率、带宽等指标的前提下，实现了对传统砷化镓功放的性能提升，并突破了硅基氮化镓功放芯片的量产技术，在业内首次实现了硅基氮化镓功放芯片在终端射频领域的量产交付。新产品具备高功率、高效率、高宽带特性，可为客户进一步降低能耗，降低系统链路设计的复杂度，助力客户进一步提升手机等终端的数据传输速率、降低工作能耗。

二、新产品对公司的影响

硅基氮化镓功放芯片产品已在国内头部终端厂商完成认证，量产交付超过100万只。公司将持续进行技术方案的升级，加速在终端厂商的应用验证。随着终端应用对射频功放要求的持续提升，大功率、高带宽、高效率射频功放成为技术发展趋势，当前主流的砷化镓射频功放技术受限于材料特性，面临性能

局限性的挑战。硅基氮化镓功放芯片具备新型三代半导体材料的性能优势，将随着硅基氮化镓功放芯片产业链的技术进步和规模扩张，进一步扩大产品优势并持续提升。预计公司新产品将持续对现有砷化镓终端功放产品形成替代，并有望在终端射频功放领域全频段、全场景推广应用，该产品系列有望为公司营收提供第二增长曲线。

公司基于多年射频功放研发经验，将持续投资新型三代半导体在终端市场的应用。公司将对新产品进行系列化开发，适配多频段、高效率终端应用场景。公司将保持对产业链持续投入，推动新型三代半导体材料的产业化发展。

三、相关风险提示

公司新产品导入周期较长，新技术的持续迭代需要研发周期，大批量销售尚需一定的周期和前期技术服务投入，存在不确定性，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。同时半导体行业技术开发投资大，下游需求随着行业变化存在一定的波动性，新产品尚面临未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2025年10月30日